

из протокола № 5 от 22.01 .2016 г.

Заседания кафедры ТТЭМ физ.-мат. факультета

Присутствовали: Э.А. Сенокосов, В.И. Чукита, В.М. Ишимов, В.М. Бочарова, Н.И.

Мацкова, И.В. Деменьтьев, Т.И. Гоглидзе, Е.С. Абрамова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Информацию зав. кафедрой Твердотельной электроники и микроэлектроники профессора Сенокосова Э.А., о подготовленной ст. преподавателем Чукита В.И. статье «Фотоэлектрические свойства слоев CdSe, выращенных методом вакуумного напыления в квазизамкнутом объеме на подложках кристаллов (0001) слюды (мусковит)», для публикации в журнале «Вестник ПГУ. Статья проверена на антиплагиат, уникальность текста составила 91% . (см. приложение)

ВЫСТУПАЛИ: доцент И.В. Деменьтьев, доцент В.М. Ишимов:

1. Электрооптические характеристики, высокая фоточувствительность к видимому свету, большое отношение темнового сопротивления к световому, зависящие от химического состава, степени чистоты и совершенства кристаллической структуры, определяют перспективу более широкого применения полупроводникового соединения CdSe в современной электронике и оптоэлектронике.
2. В статье определены основные фотоэлектрические характеристики при 300 К эпитаксиальных слоев n-CdSe, выращенных в квазизамкнутом объеме на кристаллах слюды (мусковит) в условиях, близких к термически равновесным.
3. Авторами определена удельная интегральная токовая чувствительность образцов, изготовленных на основе эпитаксиальных слоев CdSe/слюда при приложенном напряжении 100 В и освещенности 200 лк, составила величину $375 \cdot 10^3$ мкА/лк · В.
4. Выдержан общий стиль статьи.
5. Статья оформлена соответственно требованиям по оформлению статей.

РЕШИЛИ: 1. Рекомендовать для рассмотрения и публикации статью «Фотоэлектрические свойства слоев CdSe, выращенных методом вакуумного напыления в квазизамкнутом объеме на подложках кристаллов (0001) слюды (мусковит)» в журнале «Вестник ПГУ».

Председатель, профессор

Сенокосов Э.А.

Секретарь, специалист

Бочарова В.М.

